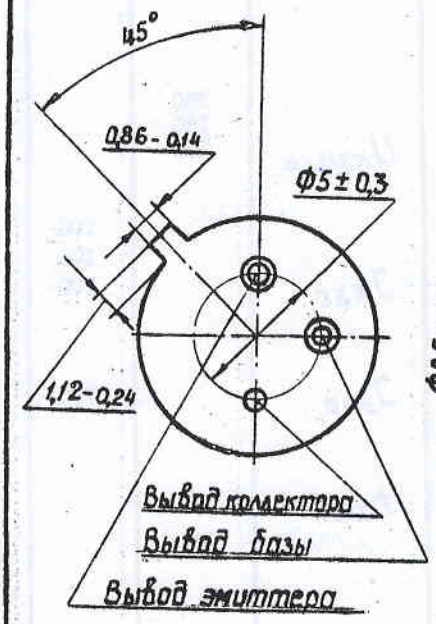
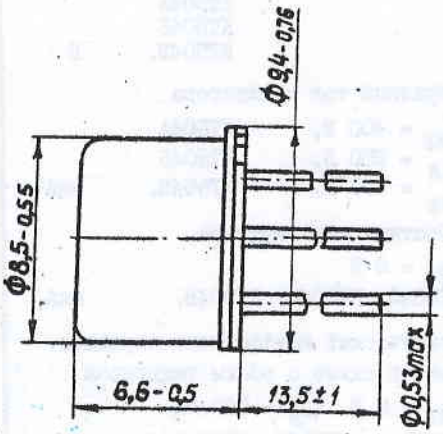
ЭТИКЕТКА

Транзисторы типов
КТ504А, КТ504Б, КТ504В
соответствуют ГОСТ 11630 - 84
и техническим условиям
аА0.336.682 ТУ





Масса не более 2 г
Содержание драгметаллов в 1000 шт.
транзисторов
золото 16,9 мг серебро ———

18.01.85. Т. Вин.

conector.by

Основные электрические параметры при $t_{окр.ср.} = +25^{\circ}C \pm 10^{\circ}C$

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Граничное напряжение $I_К$ = 30 мА, $I_{К нас}$ = 100 мА ± 10 %, $L_К$ = 160 мГн ± 10 %, $Q \geq 50$, $U_{огр}$ = 320 В ± 10 %			
КТ504А	$U_{КЭ0гр}$	250	
КТ504Б		150	
КТ504В, В		230	
Обратный ток коллектора			
$U_{КБ}$ = 400 В, КТ504А	$I_{КБ0}$		100
$U_{КБ}$ = 250 В, КТ504Б			100
$U_{КБ}$ = 300 В, КТ504В, мкА			100
Обратный ток эмиттера $U_{ЭБ}$ = 6 В КТ504А, КТ504Б, КТ504В, мкА	$I_{ЭБ0}$		100
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером $U_{КБ}$ = 5 В, $I_Э$ = 500 мА КТ504А, КТ504Б, КТ504В	$h_{21Э}$	15	
Напряжение насыщения коллектор–эмиттер $I_К$ = 500 мА, $I_Б$ = 100 мА, КТ504А, КТ504Б, КТ504В, В	$U_{КЭнас}$		1
Напряжение насыщения база–эмиттер $I_К$ = 500 мА, $I_Б$ = 100 мА, КТ504А, КТ504Б, КТ504В, В	$U_{БЭнас}$		1,6

Штамп ОТК

Л.Н.

conector.by